

Chiny gonią Zachód

28 grudnia 2012

Instytut Mikroelektroniki Chińskiej Akademii Nauk poinformował o stworzeniu rodzimego 22-nanometrowego tranzystora MOSFET z metalową bramką i materiałami o wysokiej stałej dielektrycznej. Chińczycy zapewniają, że urządzenie charakteryzuje się światowej klasy wydajnością. Nie podano żadnych szczegółów dotyczących nowego produktu.

Jeśli Chiny rzeczywiście stworzyły taki tranzystor, to można stwierdzić, że w rozwoju technologii IT Państwo Środka dzieli od Zachodu zaledwie 2-4 lata. Obecnie czołowi światowi producenci oferują komercyjne procesory korzystające z technologii 22 nanometrów i przygotowują się do wdrożenia 20-nanometrowych i mniejszych procesów produkcyjnych. Chiński wytwórca układów scalonych SMIC oferuje obecnie układy wykonane w technologii 40 nanometrów.

Opracowanie: Mariusz Błoński

Na podstawie: EE Times

Źródło: [Kopalnia Wiedzy](#)